

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成16年10月28日(2004.10.28)

【公表番号】特表2001-501774(P2001-501774A)

【公表日】平成13年2月6日(2001.2.6)

【出願番号】特願平9-529385

【国際特許分類第7版】

H 0 1 L 21/52

【F I】

H 0 1 L 21/52 B

【手続補正書】

【提出日】平成15年10月2日(2003.10.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

手 続 補 正 書

平成15年10月2日

特許庁長官 今井 康夫 殿



1. 事件の表示

平成9年 特許願 第529385号

2. 補正をする者

住 所 アメリカ合衆国 カリフォルニア 90067-2199

ロサンゼルス センチュリー パーク イースト-

90/110/シーシー 1840

名 称 ノースロップ グラマン コーポレーション

3. 代 理 人 〒530-0047

住 所 大阪市北区西天満5丁目1-3南森町パークビル

電話 (06) 6365-0718

ファクシミリ (06) 6365-9279

氏 名 弁理士(6524)野 河 信太郎



4. 補正対象書類名

「請求の範囲」

5. 補正対象項目名

「請求の範囲」

6. 補正の内容

請求の範囲を別紙のとおり補正する



方 式 査



請求の範囲

1. (a) 上面がめっきされたパッケージを準備し、
(b) SiCダイを準備し、
(c) 前記SiCダイ上に、SiCダイに結合する第1層を形成し、
(d) 前記第1層上に、第1層に結合する第2層を形成し、
(e) 前記第2層がパッケージに装着されるように該パッケージ上にSiCダイをスクラビングすることからなるSiC用ダイ装着方法。
2. 工程(c)で、上面がめっきされたパッケージを準備する請求項1記載の方法。
3. 工程(c)で、SiCダイ上に第1層としてニッケル層を形成する請求項1記載の方法。
4. 工程(c)で、2000~10000Å(ここで、Åはオングストロームを示す)の厚さのニッケル層を形成する請求項3記載の方法。
5. 工程(d)で、第1層上に第2層としてアモルファスシリコン層を形成する請求項1記載の方法。
6. 工程(d)で、5000~30000Å(ここで、Åはオングストロームを示す)の厚さのアモルファスシリコン層を形成する請求項5記載の方法。
7. 工程(d)で、第1層上に第2層としてアモルファスシリコン層を形成し、
工程(e)で、Au-Si共晶を形成するように前記パッケ

ージ上にSiCダイをスクラビングする請求項2記載の方法。

8. 工程(c)で、SiCダイ上に第1層としてニッケル層を形成する請求項7記載の方法。

9. 工程(e)で、めっき及び第1層が共晶を形成するようにパッケージ上にSiCダイをスクラビングする請求項7記載の方法。

10. 工程(d)で、第1層上に第2層としてゲルマニウム層を形成する請求項1記載の方法。

11. 工程(d)で、第1層上に第2層としてスズ層を形成する請求項1記載の方法。